



FY26 2Q/1H 決算説明資料

リガク・ホールディングス株式会社
2026年8月7日

本資料には、当社または当社グループに関連する見通し、計画、目標などの将来に関する記述がなされています。これらの記述には、「予想」、「予測」、「予定」、「期待」、「意図」、「計画」、「可能性」やこれらの類義語が含まれることがありますが、これらに限られるものではありません。これらの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報をもとに、本資料の作成時点における当社の判断に基づいて記載したものであり、また、一定の前提・仮定の下になされています。そのため、これらの記述または前提・仮定は、様々なリスクや不確定要素に左右され、実際の結果はこれと大幅に異なる可能性があります。

当社の現在の決算期は12月末であります。また、当社は、2022年1月1日を移行日として、2023年12月期より国際財務報告基準（以下「IFRS」といいます）を採用しております。

本資料には、研究開発費比率、設備投資額比率、フリーキャッシュ・フローなど、当社のNon-IFRS指標に関する記述がありますが、これらはIFRS、日本基準その他の会計基準に基づく財務数値に代替するものではありません。かかるNon-IFRS指標の当社における使用、定義および算定は、他社における同様の名称の財務指標とは大きく異なる可能性があり、直接的に比較することはできません。これらの財務数値の算出根拠等の詳細についてはAppendixをご参照ください。また、本資料には、製品区分別売上収益および営業利益並びにエンドマーケット別売上収益等の管理会計ベースの財務情報が含まれています。当該財務情報は日本基準またはIFRSに基づき作成されたものではなく、監査を受けたものでもありません。

本資料における記述は本資料の日付（またはそこに別途明記された日付）時点のものであり、当社は、それらの情報を最新のものに随時更新するという義務も方針も有しておりません。そのため、本資料に記載されている将来の見通しと実際の結果は必ずしも一致するものではありません。また、本資料に記載されている当社および当社グループ以外の企業等に関する情報は、公開情報または第三者が作成したデータ等から引用したものであり、かかる情報の正確性・適切性等について、当社は何らの検証も行っておらず、また、これを保証するものではありません。

なお、本資料における金額表記は億円未満を切り捨てて表示し、比率の数値は少数第2位を四捨五入して表示しています。

1. FY26 2Q/1H 連結決算概要
2. 半導体プロセス・コントロール機器事業アップデート
3. FY26 業績見通し

FY26 2Q/1H 連結決算概要

FY26 2Q/1H 連結決算ハイライト

全社

- 2Q：売上収益YoY7%成長、受注は同50%超の成長。足元の受注予測も引き続き強く、成長軌道は明確に
- 1H：ほぼ計画線上の売上、及び受注の進捗。受注はYoY25%超の成長。パイプラインも前年同月比35%超成長
- ただし、粗利率/営業利益率の改善は道半ば。2Hのボリューム増/値上げ/新製品効果で挽回

多目的 分析機器

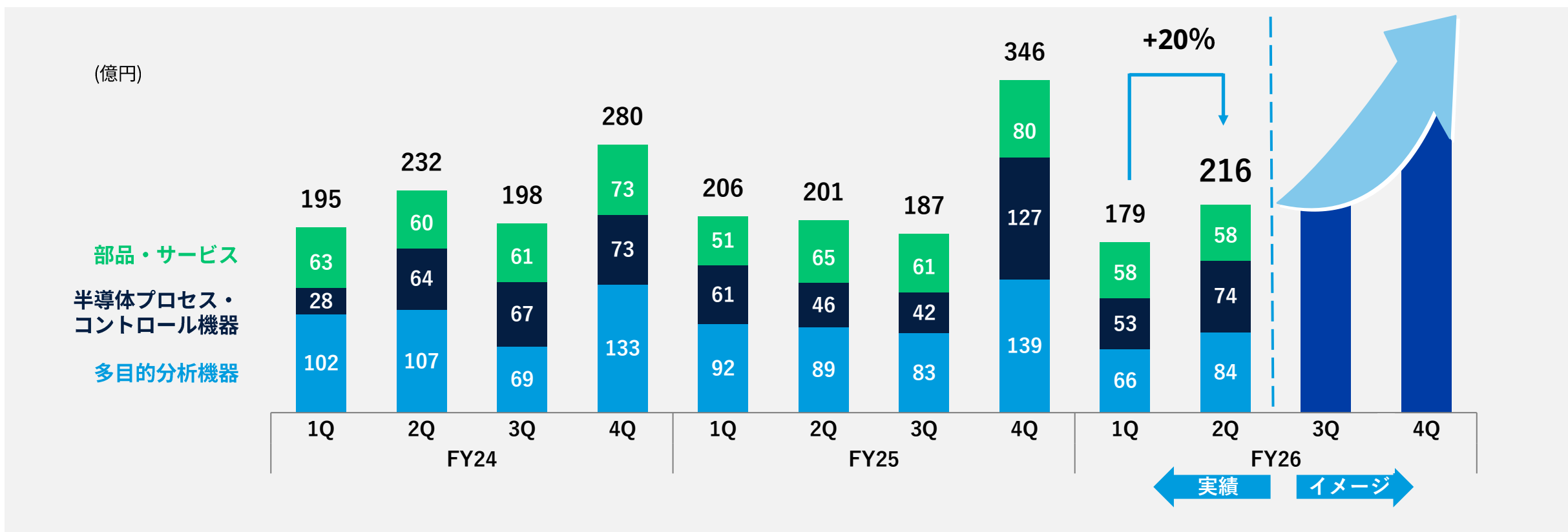
- 2Q：売上収益の回復タイミングが年初想定より遅れるも、ほぼ前年水準近くまで回復
- 1H：受注YoY5%成長。2Qは特に受注YoY日本で+20%超、米州で+50%の高成長。足元の受注予測も強い
- アカデミアからインダストリーへのシフトが受注へ反映開始。2H以降の大きな売上収益成長に期待

半導体 プロセス・ コントロール 機器

- 2Q：売上収益YoY60%成長、受注はYoY3倍超。足元受注予測も非常に強い
- 1H：売上収益YoY18%成長、受注同86%成長。共に計画を上回り進捗
- メモリ増産需要と北米IDM需要回復に加えて、JEP等新製品開発も順調に進捗

四半期毎売上収益の推移

- 2Qは端境期の1Qから予定通り大きく回復して成長軌道に復帰、1Hとしても計画比インライン
- 足元では半導体プロセス・コントロール機器事業のメモリ・ロジックの旺盛な需要、多目的分析機器事業は受注の強さにより、2Hの大きな売上収益の拡大に向けて順調に進捗



FY26 2Q 連結業績サマリー (YoY)

(億円)

	2025 2Q	2026 2Q	前年同期比
売上収益	201	216	7.4%
売上総利益	111	119	7.0%
営業利益	28	19	-32.4%
営業利益率(%)	14.3%	9.0%	-5.3pt
税引前利益	27	16	-39.6%
四半期利益	18	12	-30.2%
基本的EPS(円)	8.23	5.74	-
EBITDA	41	33	-18.4%
EBITDA率(%)	20.4%	15.5%	-4.9pt

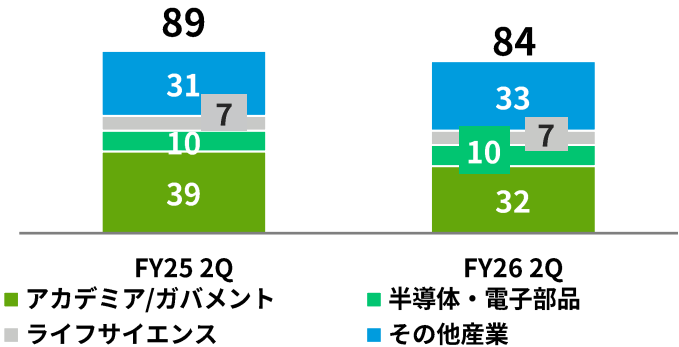
- 売上収益は、半導体プロセス・コントロール機器における増収により連結ベースで増加
- 売上総利益率はほぼ対前年比横ばい
- 売上総利益が微増にとどまる中で計画に沿った戦略投資は継続。結果、営業利益は前年同期を下回る
- 戦略投資額はほぼ計画通りで推移しており、年間通じて予定通りの売上収益規模に達することで戦略投資の利益率への影響は、年初予定通りほぼフラット。後は売上総利益率をどれだけ上げられるかが鍵に

FY26 2Q カテゴリー別業績サマリー

多目的分析機器

(億円)

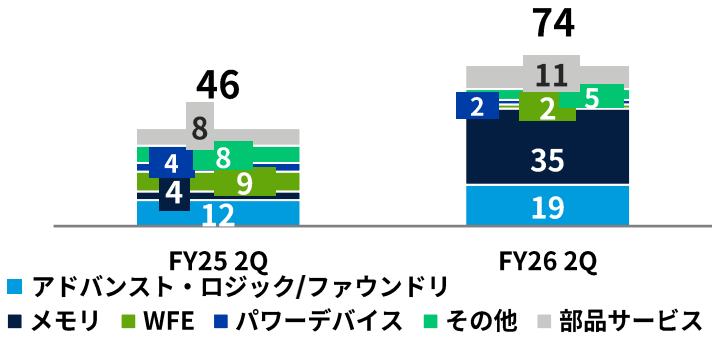
	FY25 2Q	FY26 2Q	YoY
売上収益	89	84	-6.1%
営業利益	13	3	-77.3%
営業利益率 (%)	15.0%	3.6%	-11.3pt



- ・昨年来のトランプ政策影響等によるアカデミア分野での減収傾向は長期化。
- ・粗利率はミックスの改善で前年同期比並みを維持。ボリューム減とSGA投資継続で減益
- ・アカデミアからインダストリーへのシフトを進め受注が2Qから反転

半導体プロセス・コントロール機器

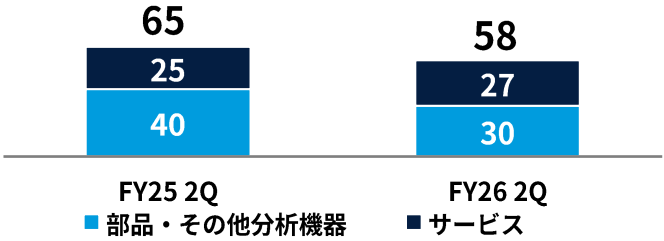
	FY25 2Q	FY26 2Q	YoY
売上収益	46	74	+60.0%
営業利益	8	14	+69.4%
営業利益率 (%)	17.9%	18.9%	+1.0pt



- ・メモリ、ロジックで売上大幅伸長
- ・営業利益は売上増に伴い増加、利益率も向上
- ・売上収益は新製品中心に2Hに集中、マージンは1H比向上の見込み

部品・サービス

	FY25 2Q	FY26 2Q	YoY
売上収益	65	58	-11.3%
営業利益	15	6	-60.1%
営業利益率 (%)	23.3%	10.5%	-12.8pt

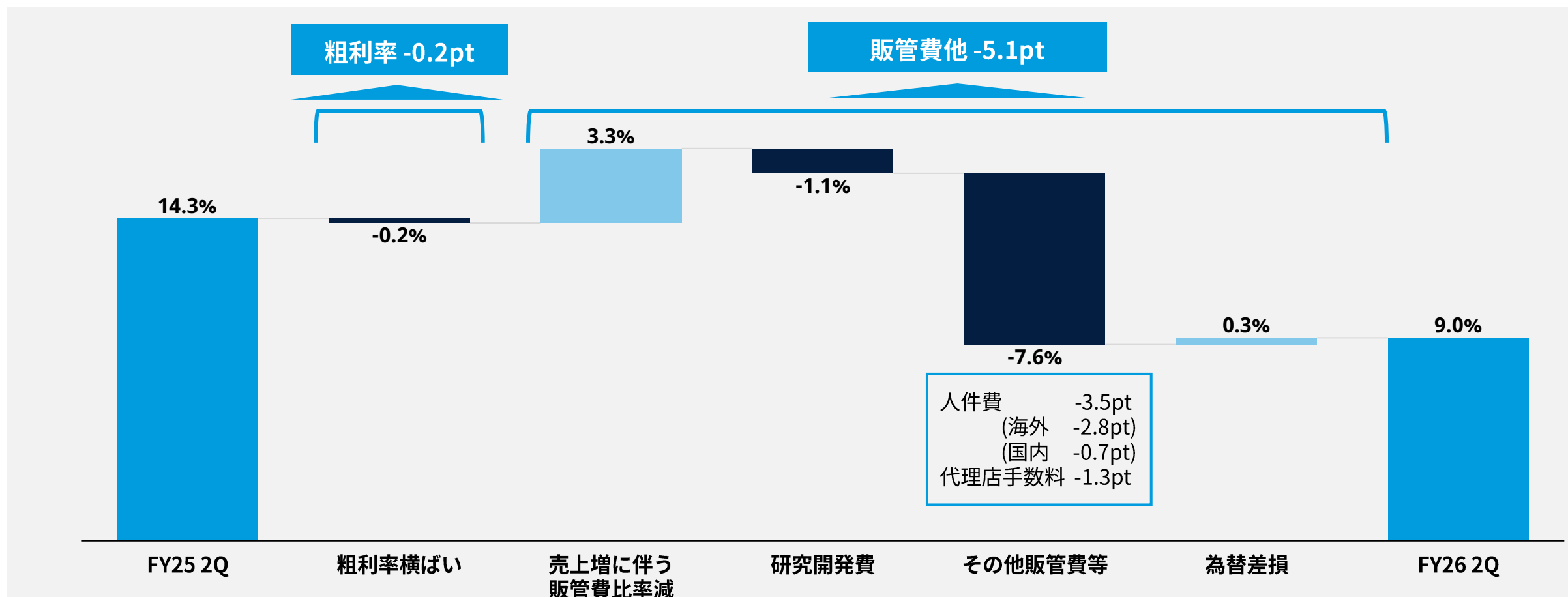


- ・サービスは11%増収。値上げ、拡販施策等効果で順調に推移
- ・その他分析機器における売上2Hシフトで全体では減収（EUVミラー、携帯ラマン、PCI）
- ・営業利益は売上の2Hシフトで減少

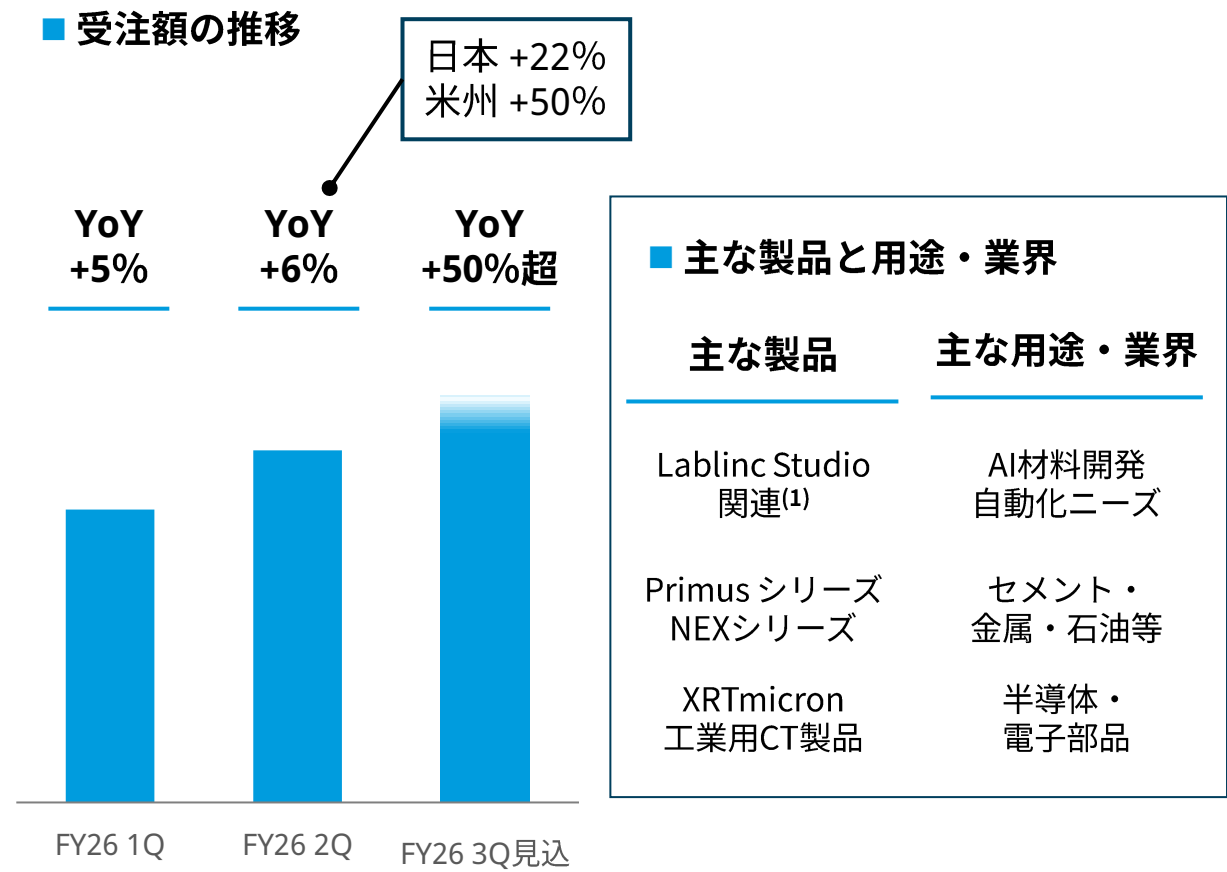
FY26 2Q 連結営業利益要因分析 (YoY)

■ 営業利益率 9.0% 前年同期比 5.3pt減

- 粗利率は、前年からコスト増影響あるも販売価格上昇や顧客・製品ミックス改善によりほぼ横ばい
- 売上減に加え、継続した戦略投資により、研究開発費と販管費（主に半導体事業強化の人件費と海外成長投資）の割合が増加。



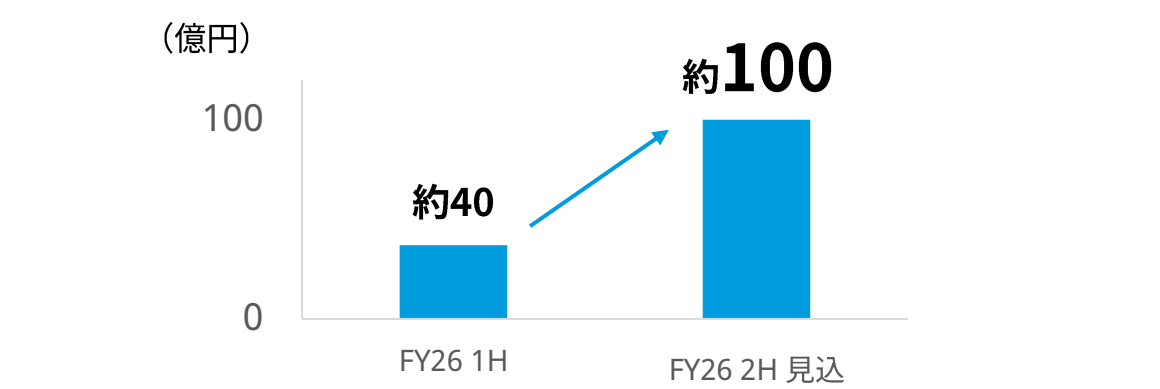
多目的分析機器：受注はアメリカが2Q底入れ、3Q好転へ



半導体プロセス・コントロール機器：JEP⁽²⁾は順調に進捗



JEP⁽²⁾の進捗にあわせて新製品の売上も下期に拡大



注:
1. LabLinc Studio関連製品には、MiniFlex、MiniFlex XpC、SmartLab、CT Lab HX、STAvesta、ZSX Primus IVが含まれます。
2. Joint Evaluation Programの略称。新技術の評価を行うために、購入契約に先立ち顧客サイトに装置を導入し、要求される性能を有するかを合同で確認するプロセス。確認できれば当装置の購入に繋がり、売上計上に伴い固定資産から売上原価に振り替えられる。

FY26 1H 連結業績サマリー (YoY)

(億円)	FY25 1H	FY26 1H	前年同期比
売上収益	407	395	-2.9%
売上総利益	227	216	-4.6%
営業利益	57	25	-54.9%
営業利益率(%)	14.0%	6.5%	-7.5pt
税引前利益	54	20	-62.6%
中間利益 ⁽¹⁾	37	16	-56.9%
基本的EPS(円)	16.71	7.20	-
中間配当(円)	9.40	9.50	-
EBITDA	81	53	-33.9%
EBITDA率(%)	20.0%	13.6%	-6.4pt

注:

1. 親会社の所有者に 帰属する中間利益、もしくは四半期利益に読み替え

- 売上収益は多目的分析機器の減少を半導体プロセス・コントロール機器の増加でカバーし、対前年2.9%の減少にとどまる
- 売上総利益率の低下は、半導体プロセス・コントロール機器における原価増（1Q特殊要因、為替要因、先行投資等を含む）が主要因
- 営業利益は、売上総利益率の低下に加えて、計画通りの継続的な戦略投資によるR&D、人件費増により前年同期比で減少
- 中間配当は、計画通り一株当たり9.50円で決議

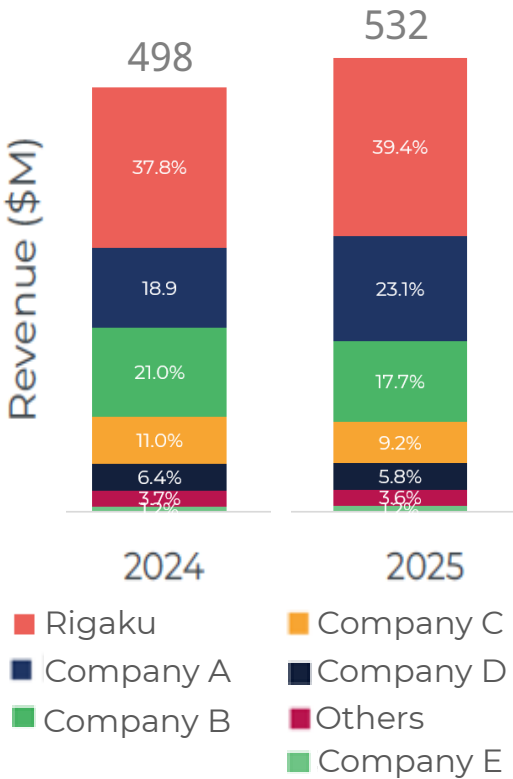
半導体プロセス・コントロール 機器事業アップデート

薄膜計測装置市場におけるリガクのシェアアップデート



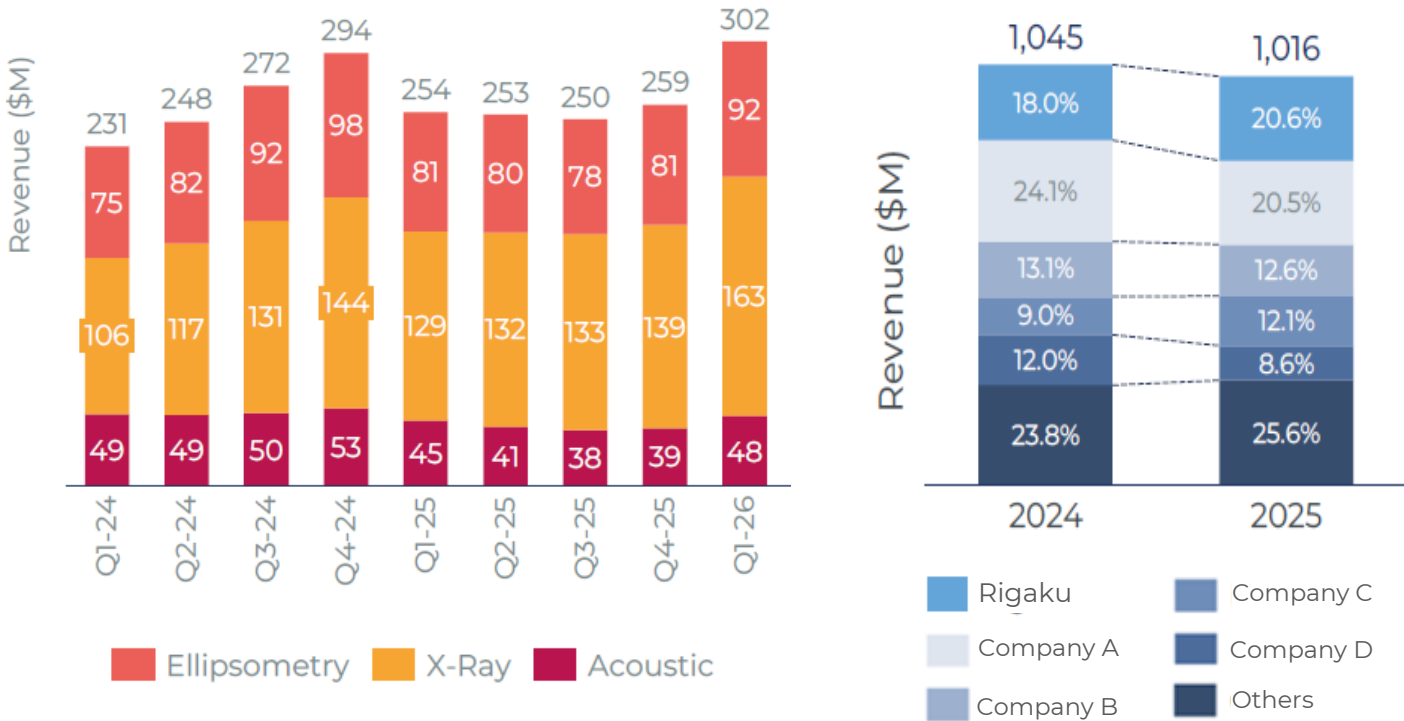
X-ray Metrology Market Share

■ リガクはシェア拡大し1位を堅持



Film and Materials Metrology Market Share

■ 広義の膜厚・組成計測市場でもリガクはシェアを伸ばし1位を獲得



出典：Yole Wafer Fab Equipment Market Monitor 2026/Q2

次世代半導体向け戦略製品ロードマップ

市場と目標

- 次世代の半導体の開発・量産向けに新製品群をタイムリーに上市
- 戦略製品の想定SAM計 約10億ドルに対して、当社目標シェア50%以上
- 2030年売上収益目標：既存製品とあわせて1,000億円を視野に入れ、Ontoとの資本業務提携を推進

	先端計測ニーズ	開発／上市ロードマップ			想定SAM (目標シェア)@2030	主なアップデート
		2025年	2026年	2027年		
ロジック	■ GAA/CFET 3D構造形状計 (GI-SAXS)	次世代ロジック XTRAIA CD-3200G (低エネルギーGI-SAXS) 開発中			新市場 \$100M(>50%)	■ ロジック向け受注(27/Q1出荷) ■ Nano Terasu軟X線ビームラインでPOC
ロジック・メモリ共通	■ Si/SiGe超格子計測	次世代ロジック・メモリ共通 XTRAIA XD (HR-XRD) ★本格量産開始			\$100M(>70%)	■ 累計12台納入済、うちロジック・メモリ大手4社でJEP完了し量産適用開始
	■ High-k/Metal Gate 超薄膜計測	XTRAIA MF-3400(XRF/XRD複合機GEN4) ★本格量産開始			\$200M(>70%)	■ 次世代機(GEN4)出荷開始 大手ロジック・メモリで採用
	■ 軽元素超薄膜計測	ONYX 3200 軽元素対応 ★本格量産開始			新市場 \$100M(>50%)	■ AI超薄膜測定をkiller appとして ロジック3社・メモリ2社で評価開始
メモリ	■ DRAM/NAND HAR(深孔)計測 (T-SAXS)	次世代メモリ XTRAIA CD-3200T ★本格量産開始 XTRAIA CD-3300T(T-SAXS) 開発中 本格量産開始			\$100M(>50%)	■ Ontoのモデルベースソフトを搭載した3200T出荷開始。新型3300T開発中
	■ 3DDRAM多層膜応力欠陥計測	XRT-Micron (Lab/Near Fab) 3DDRAM/300mmSiC 本格量産開始 XTRAIA XT-3000 ★			\$50M(>50%)	■ Fab version (300mm in-line)を開発、半導体セールスchで販売開始
アドバンスド・パッケージング	■ HBM/CoWoS等の先端パッケージの微細バンプ／TSV等の欠陥検査	AXI(Advanced X-ray Inspection) アルファ機デモ中 ベータ機開発中 ベータ機顧客評価 ★本格量産開始			\$300M(>30%)	■ TSV中Void検査をkiller appとしてβ機開発中(26/4Q評価機出荷予定)
Hybrid Metrology	■ ロジック、メモリ立体構造形状計測	T-SAXSへOCDベースソフト搭載 ★本格量産開始 Hybrid Engine Step1 Validation H.E. Step2 Co-optimization ★			新市場 \$100M(>50%)	■ CD-SAXS-OCDのHybrid Engine共同開発開始

グローバルRTCによる顧客支援力強化

- 先端プロセス開発から量産立ち上げまでを顧客近傍で支援するためRTC（Rigaku Technology Center）をグローバルに展開。シリコンバレー、台湾に続き2026年度中にRTC-China（上海）を開設予定
 - サンプルデモによる販売支援・顧客評価の加速
 - 高度アプリケーション支援体制の構築（アプリケーションサイエンティストの採用、育成）
 - トレーニングおよび保守パーツ現地在庫化によるサービス強化



Toward 2030 and Beyond 2030

- 2030年まで、及び2030年以後の先端半導体領域の技術課題を背景とする需要拡大を捕捉可能な強固なポジショニングを形成、継続的且つ持続的な成長を目指す

半導体技術ロードマップ

リガクの強み

半導体PC機器事業の中長期成長イメージ⁽¹⁾

(億円)

Toward 2030

Beyond 2030

ロジック

- GAA
- 裏面電源供給 (BSPDN)
- High NA EUV
- New Material

- CFET
- 2Dトランジスタ
- CNTFET
- Hyper NA EUV

高精度且つ非破壊
3次元形状測定

メモリ

- 500+ 3D NAND
- HBM 4/5
- 高積層DRAM

- 3D DRAM
- MRAM / FeRAM
- IMC (In-memory computing)

高アスペクト比の深孔の
非破壊測定技術

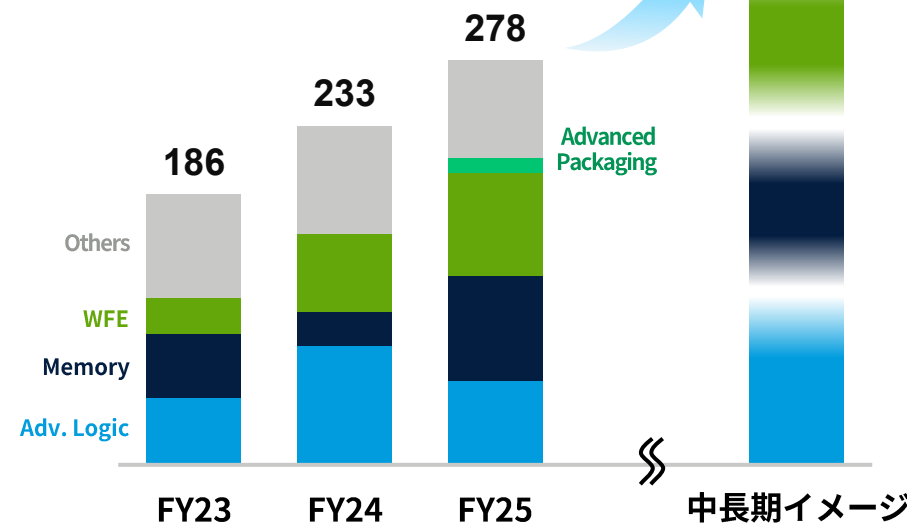
アドバンスト・パッケージング

- CoWoS
- チップレット
- Si Interposer

- CPO
- 光インターコネクト
- ガラス基板
- 先端熱ソリューション

新素材・マイクロバンプ・TSV等
構造欠陥検査における、
非破壊ハイブリッド計測
ソリューション

半導体市場の成長
×
ブレイクスルー製品で市場創出・シェアの拡大
＝リガクPC機器事業の成長



注:
1. 将来の売上収益を概念的に示したイメージ

FY26 連結業績見通し

FY26 連結業績見通し – 当面変更なし

年初ガイダンス

- 全社で売上収益は実質 +9%⁽³⁾で中計並みの成長
- 粗利率拡大でR&Dを含む販管費の増加を吸収し、利益率を向上させる戦略
- 多目的分析機器では実質 +4%⁽³⁾成長
- 半導体プロセス・コントロール機器では実質 +21 %⁽³⁾成長

1H時点での変化点

- 多目的分析機器：売上回復が年初計画より遅れ
- 半導体プロセス・コントロール機器：モメンタムは年初計画よりも明確に強い
- 部品・サービス：年間でみればほぼ計画線
- 粗利率向上を2H重点課題として取り組み中
- 中東情勢の影響は軽微だが引き続き注視

現時点での年間見通し

- 売上収益：アップサイドを予想
- 利益面：利益率については下期に向けて解像度を上げる必要あり

(億円)	FY25	FY26 ⁽²⁾	前期比
売上収益	941	1,010	+7.2%
営業利益	167	194	+16.1%
営業利益率(%)	17.7%	19.3%	+1.6pt
税引前利益	159	184	+15.2%
当期利益 ⁽¹⁾	114	125	+9.6%
基本的EPS(円)	50.19	55.27	-
EBITDA	218	253	+15.9%
EBITDA率(%)	23.2%	25.1%	+1.9pt

注：
 1. 親会社の所有者に帰属する当期利益に読み替え
 2. 対米ドル為替感応度：売上収益約2億円、営業利益約0.4億円、対ユーロ為替感応度：売上収益約0.7億円、営業利益約0.3億円
 3. 前年度と同等の為替で比較した場合

■ FY26における明確な成長軌道の兆し

- 多目的分析機器は2Qから受注が上昇軌道入り、インダストリー分野中心に下期から売上成長に本格貢献
- 半導体プロセス・コントロール機器は想定以上の拡大、新製品はJEP進捗も含めて順調

■ 中期的な成長に向けて

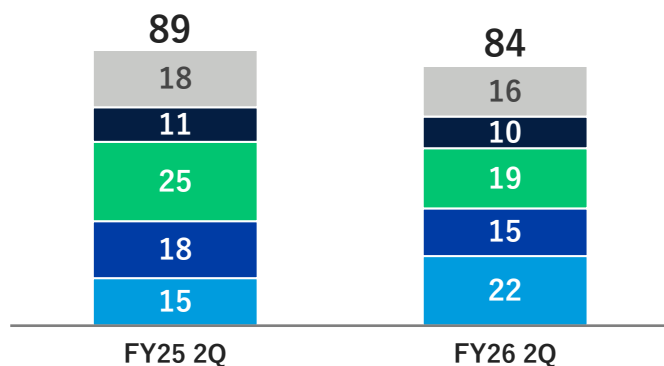
- 足元でのAI市場の評価についてはボラティリティがあるが、2030年以降も半導体技術の革新は続き、リガクの中長期的な成長ストーリーに影響なし
- ONTO Innovation との資本業務提携は予定通り下期にクローズ。本格的なハイブリッド計測ソリューションの拡大開始へ

Appendix

FY26 2Q カテゴリー別業績サマリー（地域別売上収益）

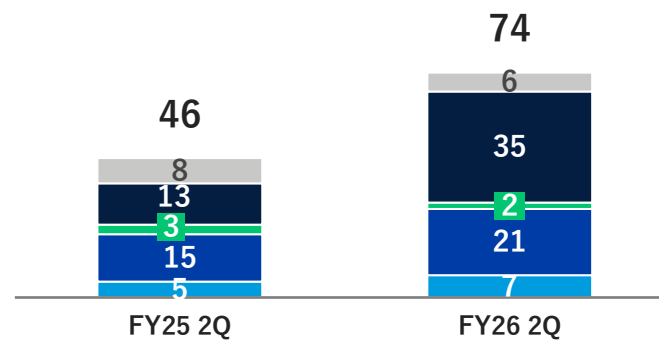
多目的分析機器

(億円)	FY25 2Q	FY26 2Q	YoY
売上収益	89	84	-6.1%
営業利益	13	3	-77.3%
営業利益率 (%)	15.0%	3.6%	-11.3pt



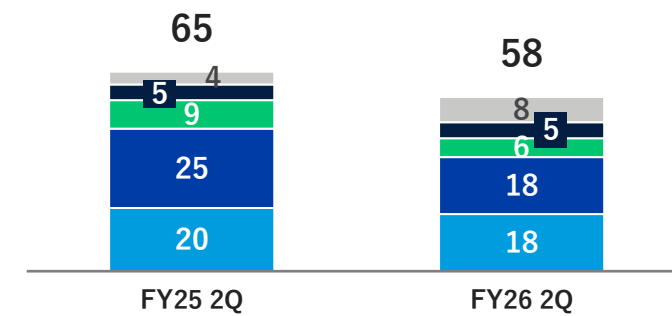
半導体プロセス・コントロール機器

	FY25 2Q	FY26 2Q	YoY
売上収益	46	74	+60.0%
営業利益	8	14	+69.4%
営業利益率 (%)	17.9%	18.9%	+1.0pt



部品・サービス

	FY25 2Q	FY26 2Q	YoY
売上収益	65	58	-11.3%
営業利益	15	6	-60.1%
営業利益率 (%)	23.3%	10.5%	-12.8pt



■ 日本
 ■ 米州
 ■ 欧州
 ■ アジア(中国以外)
 ■ 中国

- ・ 日本：インダストリーシフト先行順調
- ・ アメリカ：減収幅縮小
- ・ 中国：減税手続き決まらず2Hへ期ズレ
- ・ 欧州：アカデミア、インダストリー両面で市場が厳しい

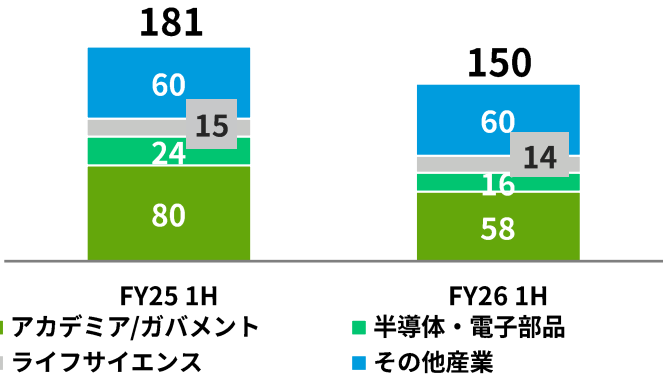
- ・ メモリ（DRAM）好調を受けアジアで大幅増
- ・ 北米IDM回復も鮮明

- ・ その他分析機器の売上2Hにシフトで米州が大きく減収

FY26 1H カテゴリー別業績サマリー

多目的分析機器

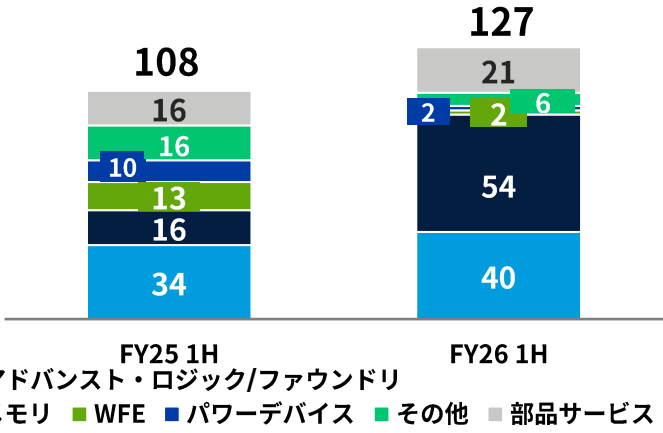
(億円)	FY25 1H	FY26 1H	YoY
売上収益	181	150	-17.1%
営業利益	25	0	-98.6%
営業利益率 (%)	14.3%	0.2%	-14.0pt



- 昨年来のトランプ政策影響等によるアカデミア分野での減収傾向は長期化。
- 粗利率はミックスの改善で前年同期比並みを維持。SGA投資継続で減益
- アカデミアからインダストリーへのシフトを進め受注が2Qから反転

半導体プロセス・コントロール機器

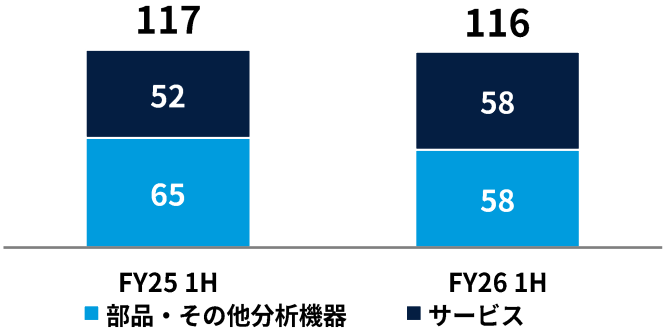
(億円)	FY25 1H	FY26 1H	YoY
売上収益	108	127	+18.2%
営業利益	24	19	-19.0%
営業利益率 (%)	22.7%	15.6%	-7.1pt



- メモリ、ロジックで売上大幅伸長
- 粗利率は1Qにおけるコスト増、製品・顧客Mixにより低下
- 売上収益は新製品中心に2Hに集中、マージンは1H比向上の見込み

部品・サービス

(億円)	FY25 1H	FY26 1H	YoY
売上収益	117	116	-0.5%
営業利益	21	16	-22.7%
営業利益率 (%)	18.0%	14.0%	-4.0pt



- サービスでは値上げ、拡販施策等の効果により13%増収
- 全体で売上は前年同期比フラットも、その他分析機器における売上2Hシフトで営業利益は減少

FY26 1H カテゴリー別業績サマリー（地域別売上収益）

多目的分析機器

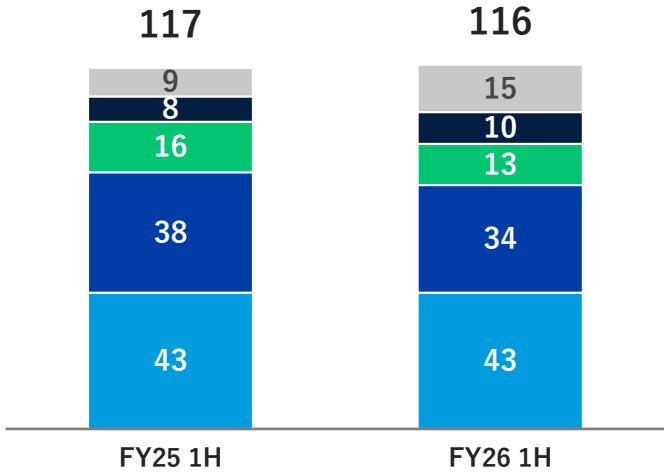
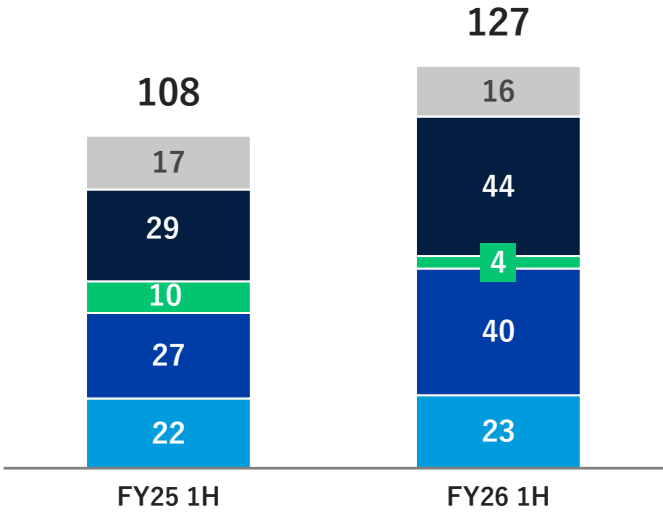
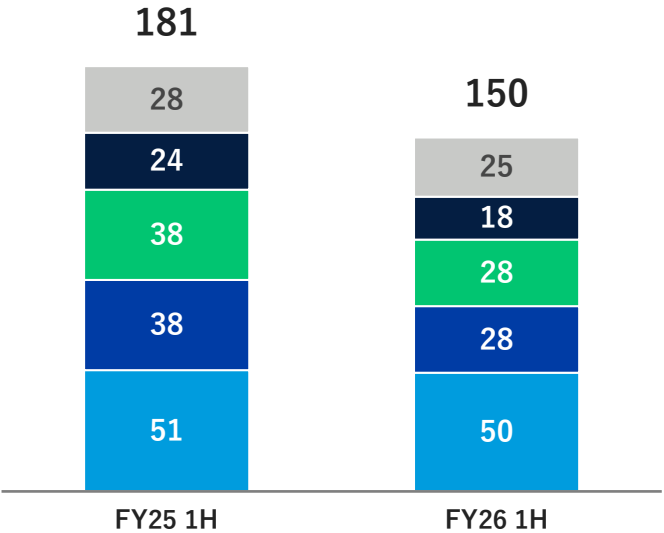
(億円)	FY25 1H	FY26 1H	YoY
売上収益	181	150	-17.1%
営業利益	25	0	-98.6%
営業利益率 (%)	14.3%	0.2%	-14.0pt

半導体プロセス・コントロール機器

FY25 1H	FY26 1H	YoY
108	127	+18.2%
24	19	-19.0%
22.7%	15.6%	-7.1pt

部品・サービス

FY25 1H	FY26 1H	YoY
117	116	-0.5%
21	16	-22.7%
18.0%	14.0%	-4.0pt

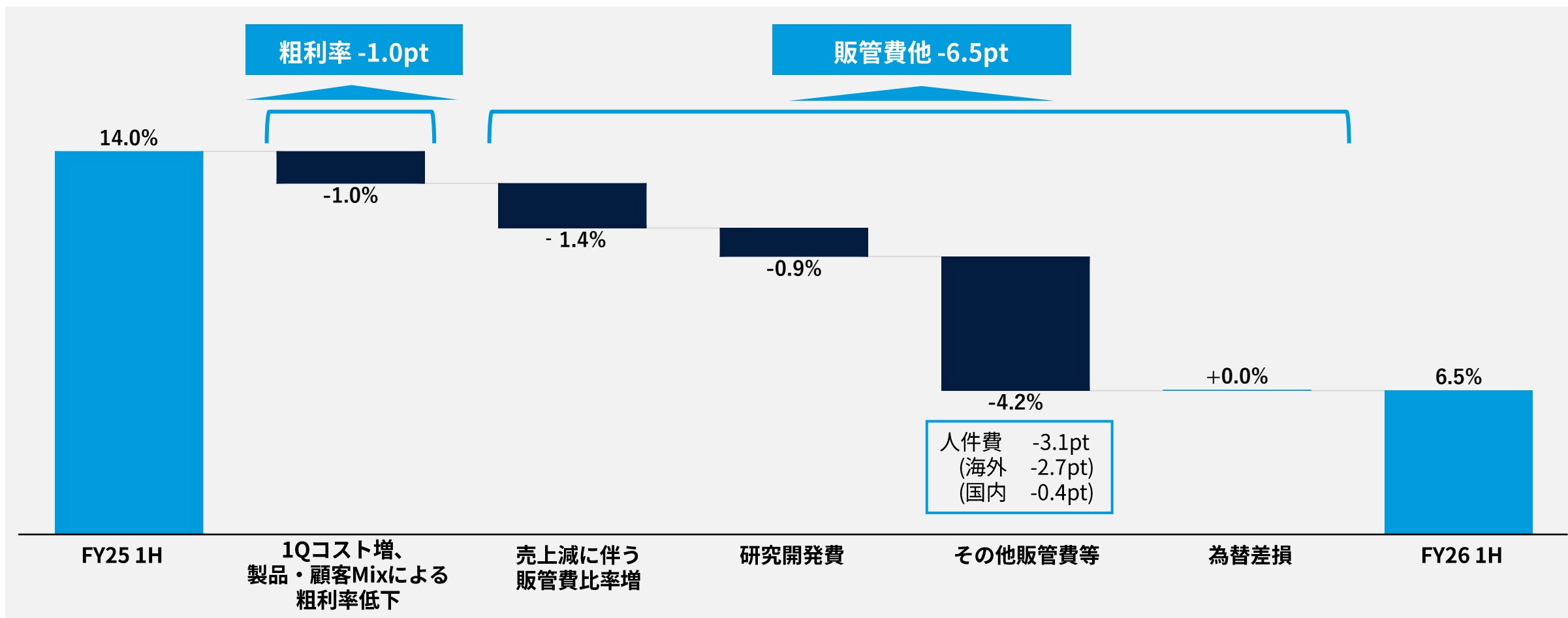


日本 米州 欧州 アジア(中国以外) 中国

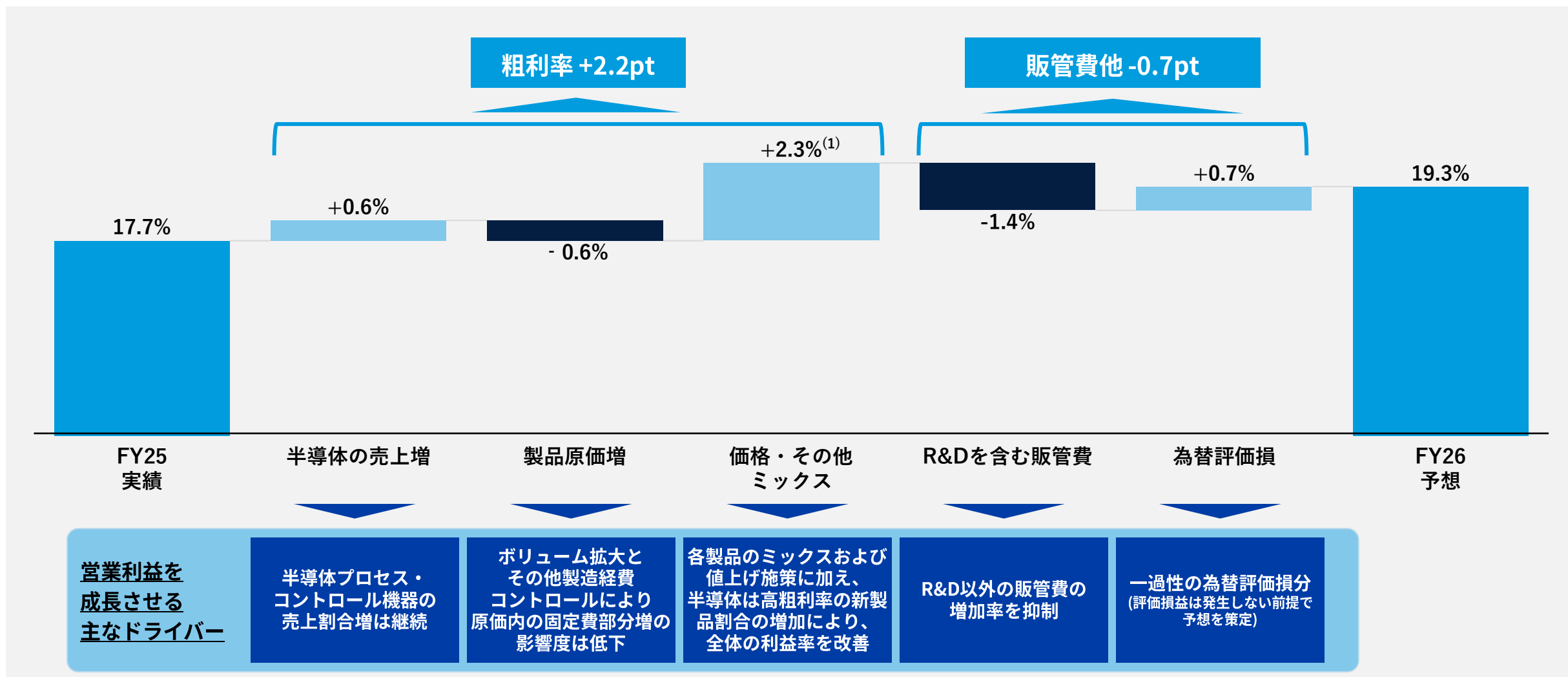
FY26 1H 連結営業利益要因分析 (YoY)

■ 営業利益率 6.5% 前年同期比 7.5pt減

- 粗利率は、主に半導体プロセス・コントロール機器における原価増(1Q特殊要因、為替要因、先行投資等含む)により低下
- 売上減に加え、継続した戦略投資により、研究開発費と販管費の割合が増加



FY26 業績予想 vs FY25 実績 営業利益要因分析



注：
+0.3%相当のサービス技術サポート費用の原価から販管費への変更含む

製品別損益 (管理会計ベース) (1)

(10億円)/(JPY Bn)	FY25					FY26				予想/Fct
	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year
多目的分析機器/Multipurpose Analytical Instruments										
売上収益/Revenue	9.2	8.9	8.3	13.9	40.4	6.6	8.4	-	-	41.5
営業利益/Operating Profit	1.2	1.3	0.4	3.1	6.2	-0.2	0.3	-	-	6.2
営業利益率/Operating Margin	13.6%	15.0%	5.4%	22.7%	15.4%	-4.0%	3.6%	-	-	14.9%
半導体プロセス・コントロール機器/Semiconductor Process Control Instruments										
売上収益/Revenue	6.1	4.6	4.2	12.7	27.8	5.3	7.4	-	-	33.3
営業利益/Operating Profit	1.6	0.8	-0.0	5.6	8.0	0.5	1.4	-	-	10.4
営業利益率/Operating Margin	26.3%	17.9%	-1.9%	44.7%	29.0%	10.9%	18.9%	-	-	31.4%
部品・サービス/Components and Services										
売上収益/Revenue	5.1	6.5	6.1	8.0	25.9	5.8	5.8	-	-	26.0
営業利益/Operating Profit	0.5	1.5	1.1	1.8	5.1	1.0	0.6	-	-	4.7
営業利益率/Operating Margin	11.2%	23.3%	19.0%	23.2%	19.8%	17.4%	10.5%	-	-	18.3%
連結合計/Consolidated Total										
売上収益/Revenue	20.6	20.1	18.7	34.6	94.1	17.9	21.6	-	-	101.0
営業利益/Operating Profit	2.8	2.8	0.8	10.1	16.7	0.6	1.9	-	-	19.4
営業利益率/Operating Margin	13.8%	14.3%	4.5%	29.2%	17.7%	3.5%	9.0%	-	-	19.3%

注：

1. 本情報は、投資家の皆さまの理解のために参考情報として作成したものであり、本社費を加味していないため、連結営業利益は各カテゴリーの合計値と一致しません

地域別、エンドマーケット別売上収益

地域別売上収益

(10億円)/(JPY Bn)	FY25					FY26				
	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year
日本/Japan	7.7	4.1	4.8	10.7	27.4	6.9	4.8	-	-	-
米州/Americas	4.5	5.9	4.0	8.9	23.4	4.6	5.5	-	-	-
欧州/EMEA	2.7	3.8	2.6	4.6	13.8	1.7	2.8	-	-	-
アジア(中国以外)/Asia (ex. China)	3.1	3.0	3.7	6.9	16.8	2.0	5.2	-	-	-
中国/China	2.3	3.2	3.4	3.5	12.5	2.5	3.1	-	-	-
売上収益合計/Total Revenue	20.6	20.1	18.7	34.6	94.1	17.9	21.6	-	-	-

エンドマーケット別売上収益

(10億円)/(JPY Bn)	FY25					FY26				
	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year
半導体・電子部品/ Semiconductor/Electronic Components	7.7	6.1	4.9	14.3	33.3	6.0	8.7	-	-	-
ライフサイエンス/Life Science	0.9	0.8	1.3	1.9	5.0	0.8	0.9	-	-	-
その他産業/Other Industries	3.4	3.5	3.5	5.1	15.7	3.4	4.1	-	-	-
アカデミア&ガバメント/ Academia/Governments	4.6	5.9	5.1	9.1	24.8	3.1	3.6	-	-	-
サービス/Services	3.7	3.6	3.7	4.1	15.1	4.4	4.1	-	-	-
売上収益合計/Total Revenue	20.6	20.1	18.7	34.6	94.1	17.9	21.6	-	-	-

連結 四半期業績



	FY25					FY26					予想/Fct
(10億円)/(JPY Bn)	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year	
売上収益/Revenue	20.6	20.1	18.7	34.6	94.1	17.9	21.6	-	-	101.0	
売上総利益 ⁽¹⁾ /Gross Profit ⁽¹⁾	11.5	11.1	9.7	20.4	52.8	9.7	11.9	-	-	58.9	
営業利益/Operating Profit	2.8	2.8	0.8	10.1	16.7	0.6	1.9	-	-	19.4	
税引前利益/Profit Before Taxes	2.7	2.7	0.6	9.8	15.9	0.4	1.6	-	-	18.4	
当期利益/Net Profit	1.9	1.8	0.4	7.1	11.4	0.3	1.2	-	-	12.5	
基本的EPS (円) /Basic EPS (JPY)	8.52	8.23	2.18	31.38	50.19	1.46	5.74	-	-	55.27	
Non-IFRS Indicator											
調整後営業利益/Adjusted Operating Profit	3.3	3.3	1.3	10.6	18.6	1.1	2.4	-	-	21.5	
調整後当期利益/Adjusted Net Profit	2.2	2.1	0.8	7.4	12.7	0.6	1.6	-	-	13.9	
調整後EPS (円) /Adjusted EPS (JPY)	-	-	-	-	55.19	-	-	-	-	61.40	
EBITDA	4.0	4.1	2.1	11.5	21.8	2.0	3.3	-	-	25.3	
調整後EBITDA/Adjusted EBITDA	4.0	4.0	2.1	11.4	21.7	2.0	3.3	-	-	25.3	
対売上収益比率/Adjusted EBITDA Margin	19.6%	20.0%	11.7%	33.0%	23.0%	11.3%	15.5%	-	-	25.1%	
ROE	-	-	-	-	13.4%	-	-	-	-	13.5%	
調整後ROE/Adjusted ROE	-	-	-	-	14.9%	-	-	-	-	15.0%	
研究開発費/R&D Expenses	1.6	1.8	1.8	1.9	7.3	1.7	2.0	-	-	8.5	
設備投資額/CAPEX	0.6	3.4	1.0	1.5	6.6	1.0	1.9	-	-	7.7	
減価償却費/Depreciation	1.2	1.2	1.3	1.3	5.1	1.4	1.4	-	-	5.8	
JPY/USD	151.2	147.5	147.8	149.8	149.8	156.5	158.6	-	-	145.0	
JPY/EURO	159.4	162.2	165.6	169.5	169.5	183.5	184.8	-	-	165.0	

注：
FY25 Q1の売上総利益は、FY26の費用構造に合わせて一部費用の分類を変更したことに伴い、再表示しております。そのため、当初開示した数値とは異なります。なお、FY25 Q2以降については、FY26と同様の分類を適用しております。

FY26 1H B/S & キャッシュ・フロー

B/S

(10億円)/(JPY Bn)	FY25 Year-end	FY26 2Q	Changes
流動資産/Current Assets	76.2	77.7	1.4
現預金/Cash and Cash Equivalents	24.2	27.2	2.9
棚卸資産/Inventories	20.8	25.8	4.9
営業債権、その他流動資産など/ Trade Receivables, Other Current Assets, etc.	31.1	24.7	-6.4
非流動資産/Non-Current Assets	108.9	109.8	0.9
有形固定資産/Property, Plant & Equipment	22.6	24.2	1.6
のれん、無形資産など/Goodwill, Intangible Assets, etc.	86.3	85.6	-0.6
資産合計/Total Assets	185.2	187.6	2.4

(10億円)/(JPY Bn)	FY25 Year-end	FY26 2Q	Changes
負債/Liabilities	96.8	98.4	1.6
有利子負債/Interest-Bearing Debt	62.1	66.9	4.7
その他負債/Other Liabilities	34.6	31.5	-3.1
資本合計/Total Equity	88.3	89.1	0.7
負債・資本合計/Total Liabilities and Equity	185.2	187.6	2.4

キャッシュ・フロー

(10億円)/(JPY Bn)	FY25 1H	FY26 1H	Changes
営業キャッシュ・フロー/Operating Cash-Flow	6.9	2.9	-3.9
投資キャッシュ・フロー/Investing Cash-Flow	-4.0	-3.0	1.0
フリーキャッシュ・フロー/Free Cash-Flow	2.8	-0.1	-2.9
財務キャッシュ・フロー/Financing Cash-Flow	-0.4	2.4	2.9
為替換算差異/Impact on Exchange Rate	-1.4	0.6	2.0
ネットキャッシュ・フロー/Net Cash-Flow	0.9	2.9	2.0

財務指標

	FY25 Year-end	FY26 2Q	Changes
ネットデット÷調整後EBITDA ⁽¹⁾ / Net Debt / Adjusted EBITDA ⁽¹⁾	1.7x	2.1x	-
自己資本比率/Equity Ratio	47.7%	47.5%	-

注：
1. 2025年12月期末の値はLTM合計の調整後EBITDAを用いて算出

調整後利益等における調整項目(1/2)

(10億円)/(JPY Bn)	FY25					FY26					予想/Fct
EBITDA	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year	
税引前利益/Profit Before Taxes	2.7	2.7	0.6	9.8	15.9	0.4	1.6	-	-	18.4	
減価償却費及び償却費/Depreciation and Amortization	1.2	1.2	1.3	1.3	5.1	1.4	1.4	-	-	5.8	
支払利息/Interest Expenses	0.2	0.2	0.2	0.3	1.1	0.2	0.3	-	-	1.5	
受取利息及び配当金/Interest and Dividend Income	-0.1	-0.1	-0.1	-0.0	-0.4	-0.0	-0.0	-	-	-0.4	
減損損失/Impairment Losses	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	
EBITDA	4.0	4.1	2.1	11.5	21.8	2.0	3.3	-	-	25.3	
利益率/Margin	19.6%	20.4%	11.7%	33.2%	23.2%	11.3%	15.5%	-	-	25.1%	

調整後EBITDA	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year	
EBITDA	4.0	4.1	2.1	11.5	21.8	2.0	3.3	-	-	25.3	
コンサルティング・フィー/Business Consulting Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
中国免除申請関連費用/China-related exemption application costs	-	-0.0	-	-0.0	-0.1	-	-	-	-	0.0	
調整項目計/Total Adjustments	-	-0.0	-	-0.0	-0.1	-	-	-	-	0.0	
調整後EBITDA/Adjusted EBITDA	4.0	4.0	2.1	11.4	21.7	2.0	3.3	-	-	25.3	
利益率/Margin	19.6%	20.0%	11.7%	33.0%	23.0%	11.3%	15.5%	-	-	25.1%	

調整後利益等における調整項目(2/2)

(10億円)/(JPY Bn)	FY25					FY26					予想/Fct
調整後営業利益/Adjusted Operating Profit	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year	
営業利益/Operating Profit	2.8	2.8	0.8	10.1	16.7	0.6	1.9	-	-	19.4	
PPA償却費/PPA Amortization	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	0.5	-	-	2.1	
コンサルティング・フィー/Business Consulting Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
中国免除申請関連費用/China-related exemption application costs	-	-0.0	-	-0.0	-0.1	-	-	-	-	0	
減損損失/Impairment Losses	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0	
調整項目計/Total Adjustments	0.5	0.4	0.5	0.4	1.9	0.5	0.5	-	-	2.1	
調整後営業利益/Adjusted Operating Profit	3.3	3.3	1.3	10.6	18.6	1.1	2.4	-	-	21.5	
利益率/Margin	16.3%	16.5%	7.2%	30.6%	19.8%	6.4%	11.4%	-	-	21.3%	

調整後当期利益/Adjusted Profit	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year	
当期利益/Profit	1.9	1.8	0.4	7.1	11.4	0.3	1.2	-	-	12.5	
PPA償却費/PPA Amortization	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	0.5	-	-	2.1	
コンサルティング・フィー/Business Consulting Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
中国免除申請関連費用/China-related exemption application costs	-	-0.0	-	-0.0	-0.1	-	-	-	-	0	
減損損失/Impairment Losses	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	
調整項目計/Total Adjustments	0.5	0.4	0.5	0.4	1.9	0.5	0.5	-	-	2.1	
調整項目に対する税金等調整/Tax Adjustments to Total Adjusted Items	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.6	-0.1	-0.1	-	-	-0.7	
調整後当期利益/Adjusted Profit	2.2	2.1	0.8	7.4	12.7	0.6	1.6	-	-	13.9	
利益率/Margin	11.0%	10.7%	4.5%	21.5%	13.5%	3.8%	7.6%	-	-	13.8%	

Rigaku at a Glance

Company Highlights

会社概要

- 75年のイノベーションの歴史を持つ、先端X線技術のグローバルリーダー
- 高度な研究開発力により、業界トップクラスの収益性を実現
- 半導体プロセス・コントロール分野の20%超の成長により高いEBITDAマージンと持続的な成長を実現

高い成長力と収益性を兼ね備えた財務プロファイル（2025年12月期）

売上収益
941億円

調整後EBITDA⁽²⁾
217億円
(マージン 23.0%)

半導体プロセス・コントロール機器事業
売上収益 CAGR⁽¹⁾
21%

海外売上収益比率⁽³⁾
71%

半導体前工程向け
X線計測機器シェア⁽⁶⁾
グローバル No.1

X線回折機器（XRD）
シェア⁽⁴⁾⁽⁵⁾
グローバル No.2
国内 No.1

注：

1. 2023年12月期から2025年12月期までの3年におけるCAGR

2. 調整後EBITDA=税金等調整前当期利益+減価償却費及び償却費+減損損失-受取利息及び配当金+支払利息+一時費用

3. 海外の顧客・代理店に対する売上収益に基づき算出

4. Strategic Directions International, Inc. 「SDi Global Assessment Report 2025」

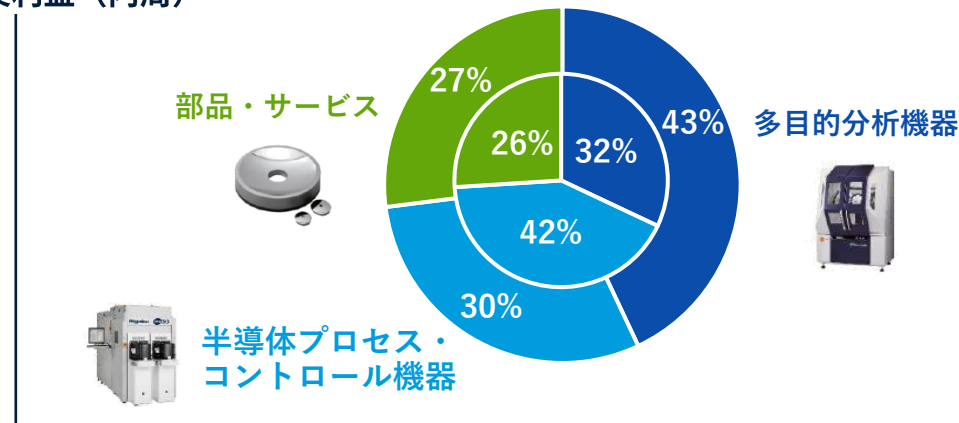
5. 株式会社アールアンドディ「科学機器年鑑 2025年版」

6. Yole Intelligence「2026 Yole Group Japan Visits - The Semiconductor Industry Trends」

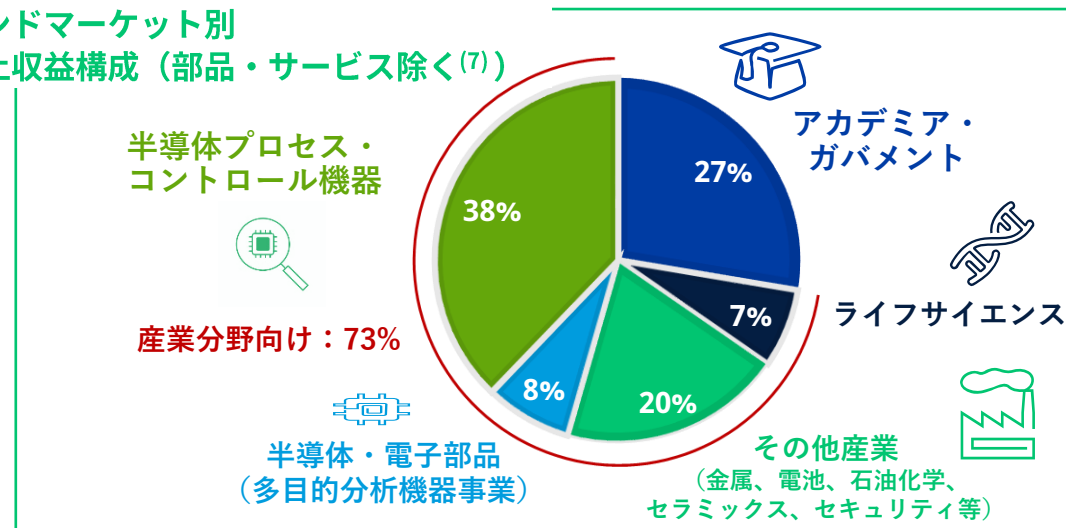
7. 部品・サービス事業の売上収益、および半導体プロセス・コントロール機器事業における部品・サービスの売上収益を除く

多様なマーケットでの事業基盤（2025年12月期）

製品別売上収益（外周）
営業利益（内周）



エンドマーケット別 売上収益構成（部品・サービス除く⁽⁷⁾）



リガクの競争優位性

要素部品の開発・製造の内製化

X線発生装置

先進的なターゲット・ローテーション技術による高いX線輝度の実現



光学素子

X線/EUV向けの先端多層膜ミラー



最適なすり合わせによる、性能の最大化

解析ソフトウェア

AIによる解析で、Metrologyに役立つ複雑構造を可視化



X線検出器

高感度X線検出器に用いられる半導体を内製



技術資産

■ 熟練したX線技術者



研究開発者数⁽¹⁾
約300

米国特許庁に登録済の
X線関連特許数⁽²⁾
212

業界トップ企業への納入実績・高いリテンション率

半導体

10社 / グローバル
上位10社⁽³⁾

製薬

10社 / 国内
上位10社⁽⁴⁾

化学製品

10社 / 国内
上位10社⁽⁵⁾



XRD製品とXRF製品に係る
既往顧客との更新商談における
リピート受注率⁽¹⁰⁾ (過去10年間)

内製化によるアドバンテージ

装置の高性能化

高速計測・高分解能・省エネルギー

開発サイクルの短縮

量産効果

注:

1. 2025年10月末時点の基礎研究／製品開発へ従事する研究開発者数

2. The United States Patent and Trademark Officeに登録されているX線関連特許数 (2025年12月時点)

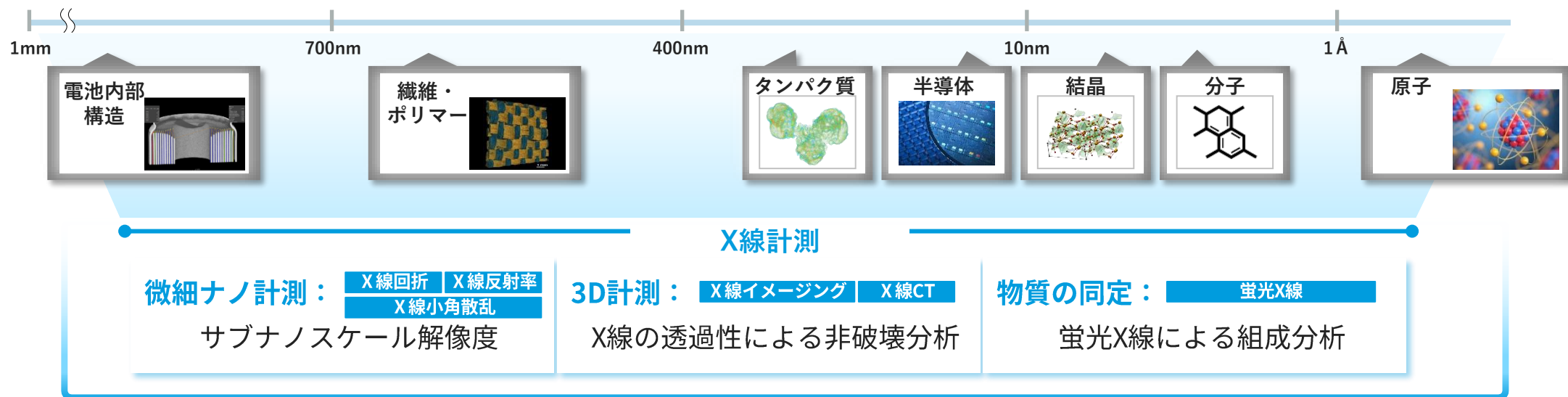
3. TechInsights, Inc. 「Capital Expenditure Forecast June 2024」

4. 東証上場株価指数において「医薬品」に分類される企業の2023年売上収益ランキングに基づく

5. 東証上場株価指数において「化学」に分類される企業の2023年売上収益ランキングに基づく

不可視の世界を可視化する：リガクのX線ソリューション

- リガクはX線独自の計測ソリューションを確立し、微細領域の検査・計測需要の高まりを中心とした、多様な分析ニーズに対応



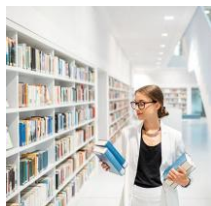
X線回折			X線イメージング・X線CT		蛍光X線		蛍光X線・X線回折・X線反射率
							
XRTmicron	MiniFlex	SmartLab	CT Lab HR160	CT Lab HV	ZSX Primus IV	Qualana	WaferX 310

エンドマーケット別当社主要製品（多目的分析機器事業）

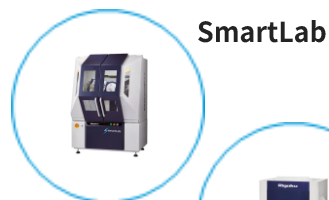
■ アカデミア・ガバメント

基礎研究・材料解析

- ✓ X線回折（XRD）



大学・研究開発機関



SmartLab



MiniFlex

■ 半導体・電子部品

〈半導体〉

組成分析・信頼性評価

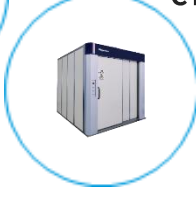
- ✓ 熱分析／蛍光X線（XRF）



半導体・薄膜



ZSX Primus IV



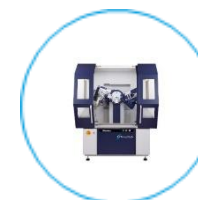
CT Lab HV



電池

〈電池〉
結晶構造・ナノ構造解析

- ✓ X線回折（XRD）
- ✓ 蛍光X線（XRF）
- ✓ 小角X線散乱（SAXS）



SmartLab



ZSX Primus IV

■ ライフサイエンス

医薬品・生体構造解析

- ✓ X線回折（XRD）
- ✓ 電子密度トポグラフィー



医薬品



XtaLAB
Synergy-ED



MoleQlyze

■ その他産業

原材料の組成・品質管理

- ✓ 蛍光X線（XRF）
- ✓ X線回折（XRD）



金属



石油・天然ガス



セラミックス



ZSX Primus IV



MiniFlex

半導体製造プロセスにおける主要製品（半導体プロセス・コントロール機器事業）

- 半導体製造工程で求められる高度な検査・計測ソリューションを提供するリガクの製品は先端半導体の製造に不可欠

薄膜・レジストの膜厚測定



WaferX 310
膜厚・組成



XTRAIA MF-3400
膜厚・組成・密度・結晶性



XTRAIA XD-3300
結晶性・膜厚・密度



ONYX 3200
膜厚・組成

- 組成・結晶性測定を含む
- 薄膜化・多層化に伴うサブナノ測定ニーズが増大

表面金属汚染分析



TXRF310 Fab



TXRF-V310

- 前工程の各フェーズにおける表面汚染分析

ウエハ
製造工程

素子・配線
形成工程

洗浄

成膜

洗浄

レジスト
コーティング

露光

マイクロバンプ形成
CoW・WoW⁽¹⁾

ダイシング

モールドイング

ボンディング

最終検査

パッケージ
工程



新製品を開発中

多目的分析機器



膜厚、レジスト・ハードマスクの形状分析



XTRAIA CD-3010G
ナノ形状



XTRAIA CD-3200T
ナノ形状

- GAA構造にも対応する非破壊での内部構造評価、先端メモリ向けの非破壊での深穴形状測定ニーズ等を捕捉

先端パッケージングでのバンプ組成・形状測定



ONYX 3200
SnAgバンプ組成、形状



WaferX 310
バンプ電極膜厚、組成

- 汚染や異物、傷等の検査
- チップレット集積で増加する配線・電極・バンプの膜厚・組成
- TSV⁽²⁾欠陥検査
- CoWoS・HBM等先端ソリューションにも対応

注：
1. CoW = Chip on Wafer, WoW = Wafer on Wafer
2. TSV = Through-silicon Via

リガクの成長戦略コンセプト（3本の矢）

- アプリケーション毎に最先端の計測需要に対応するソリューションを確立し、Lab to Fab戦略の推進により中長期成長を企図

Pillar1 基盤戦略の強化

多目的分析機器

多目的分析機器における先端X線分析
ソリューションへの需要の高まり

Pillar2 半導体でのLab to Fab戦略の推進

半導体プロセス・コントロール機器

半導体産業の発展に
必要不可欠なX線技術

Pillar3 Lab to Fab戦略の拡大展開

多目的分析機器

新たなアプリケーションの
開発による新市場の創出

- イノベーションが活発な産業分野へのLab to Fab戦略の拡大・多目的分析機器のFab仕様化

- Lab to Fab戦略を強力に推進し、半導体X線計測市場におけるグローバルリーダー
- 半導体の微細化・積層化に対応する新しいソリューションの提供で事業領域を拡大

- 卓越したX線要素技術力と強固な顧客基盤をレバレッジに、多様化・高度化する顧客のR&Dニーズに対応
- 海外コマーシャル・インフラに積極投資を行い、グローバル市場でシェア拡大

基本戦略

注力分野

- グローバルサプライチェーンの強化
- サービス事業の拡大

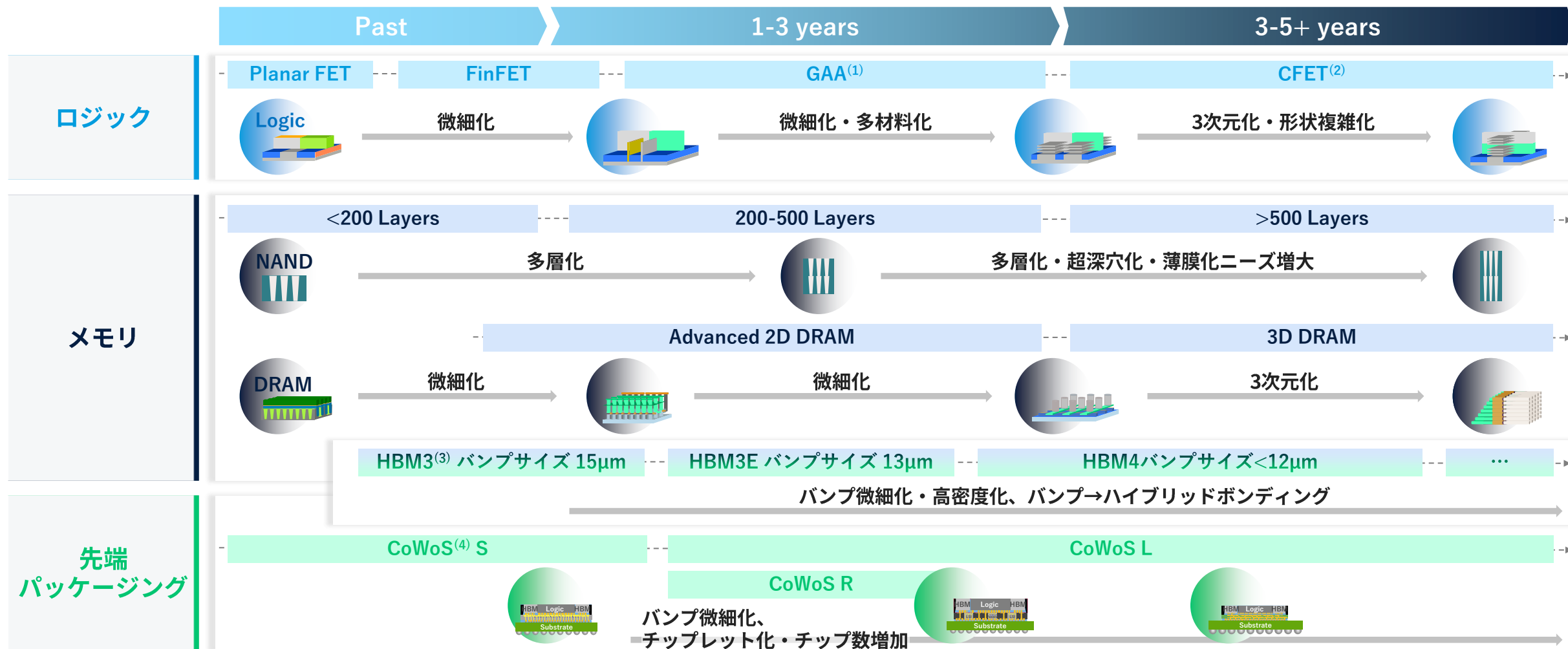
- 半導体先端技術トレンドに即したソリューション提供
- 光学・CD計測との補完により事業領域を拡大 (Hybrid Metrology)
- アドバンスド・パッケージング検査への参入

- パワーデバイス(次世代化合物半導体)
- 電池 (全・半固体電池等)
- ライフサイエンス(バイオ医薬品等)

先端半導体製造における検査・計測ニーズ

- 半導体製造工程は微細化・多材料化等による転換点を迎え、高精度検査・計測技術は一層重要に

アプリケーション別先端半導体の技術トレンド



注：

1. GAA = Gate All Around
2. CFET = Complementary FET

3. HBM = High Bandwidth Memory
4. CoWoS = Chip on Wafer on Substrate

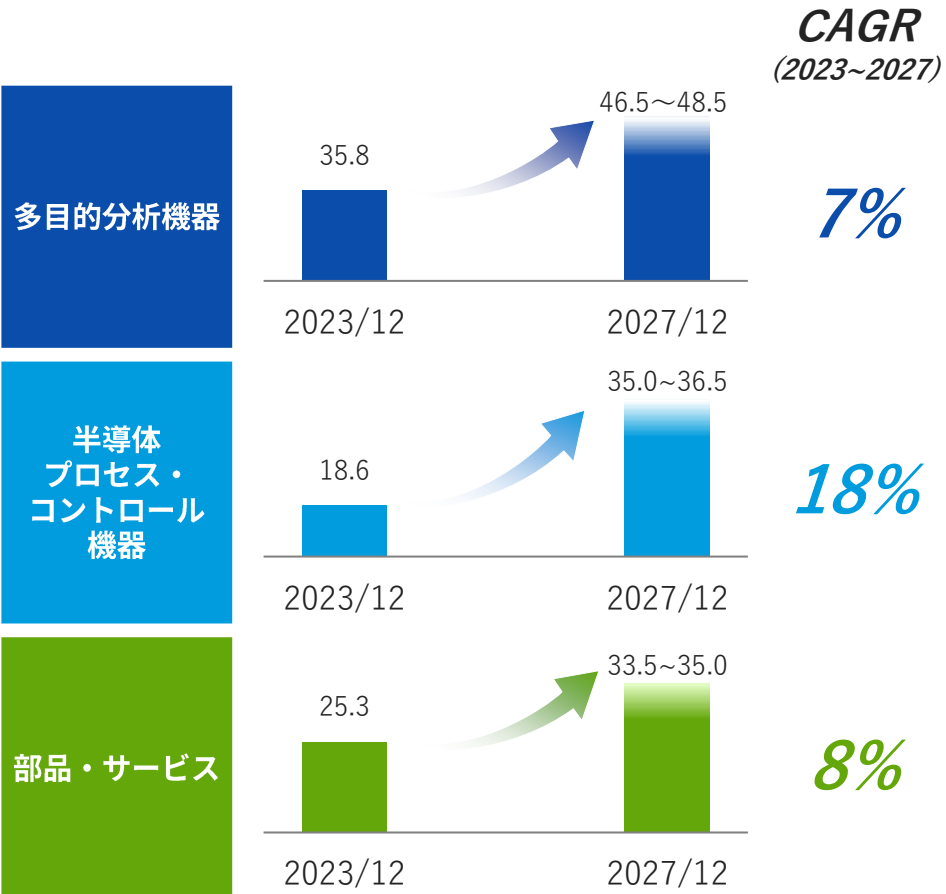
中期経営計画

■ 半導体プロセス・コントロール機器の力強い成長により、売上高年平均成長率（CAGR）約10%を目指す

中期計画目標値（全社）

製品カテゴリー別売上高成長目標（10億円）

	中計基準年度 (2023年12月期)	2025年12月期 (実績)	2026年12月期 (予想)	中期計画目標 (2027年12月期)
売上収益 YoY	798億円 27.4%	941億円 3.9%	1,010億円 7.2%	1,150~1,200億円 ⁽¹⁾ (CAGR約10%)
調整後EBITDA ⁽²⁾ Margin	202億円 25.3%	217億円 23.0%	253億円 25.1%	315~325億円 約27%
調整後営業利益 ⁽³⁾ Margin	183億円 22.9%	186億円 19.8%	215億円 21.3%	265~275億円 約23%
株主還元	-	18.8円/株	19.0円/株	配当性向 約30%
研究開発費比率 ⁽⁴⁾	6.5%	7.8%	8.5%	約9%
設備投資額比率 ⁽⁵⁾	3.5%	7.1%	7.7%	約5% ⁽⁶⁾
要員数 ⁽⁷⁾	1,994人	2,226人	2,351人	2,500~2,600人



注：
1. レンジ幅は売上収益の中期計画目標の5%の範囲内に設定（調整後EBITDA、調整後営業利益及び要員数のレンジ幅についてもそれぞれ同様）。売上収益の中期計画目標におけるYoY成長率は、2023年12月期を基準とする2027年12月期までの4ヶ年における売上収益の年平均成長率で、2025年12月期から2027年12月期までの各期の売上収益は想定為替レート（1ドル145円、1ユーロ156円）として算出
2. 調整後EBITDA＝税金等調整前当期利益＋減価償却費及び償却費＋減損損失－受取利息及び配当金＋支払利息＋一時費用
3. 調整後営業利益＝営業利益＋PPA償却費＋減損損失＋一時費用

4. 研究開発費比率＝研究開発費/売上収益
5. 設備投資額比率＝設備投資額/売上収益 設備投資額は使用権資産を除いた設備投資の金額により算出
6. 2027年12月期の設備投資額比率目標は、その分子となる設備投資額に現在時点で計画されていない山梨工場に続く大型の工場改修・増強投資を含まない
7. 要員数は年度末の就業人数と年度平均の臨時雇用人数の合計により表示

用語集

用語	説明
AXI	Automated X-Ray Inspectionの略称。X線を用いた自動検査装置。電子基板や半導体内部の欠陥を非破壊で検出し、品質管理を効率化する
CFET	Complementary FET(CFET)は、N型FETとP型FETを垂直方向に積層して統合する次世代の半導体デバイス技術 現在主流のFinFETやGAA(Gate-All-Around)FETに続く技術として期待されている
CoWoS	Chip on Wafer on Substrateの略称。TSMCが開発した先進パッケージ技術の一つ。 複数のチップをシリコンインターポーザー上に実装し、基板に搭載することで、高速・大容量のデータ処理と省スペース化を実現
DicifferX WAXS Edition	高分子フィルム、繊維、薄膜などの材料における原子・分子構造、結晶相および分子配向を高精度かつ数秒以内に測定する先進的なX線分析装置
Electron Density Topography (電子密度トポグラフィー)	結晶内部の電子の分布(電子密度)を可視化する技術。これにより、材料の原子構造や結合の状態を詳細に調べることが可能
EUV	Extreme Ultravioletの略称。波長が約13.5nmの紫外線を指し、半導体製造の露光プロセスで使用される光源技術
GAA	Gate-All-Aroundの略称。 トランジスト技術の一種で、ゲートがすべての側面からチャンネルに接触、継続的な小型化を可能にするトランジスタ構造を指す
GaN	ガリウム(Ga)と窒素(N)で構成される化合物半導体材料

用語	説明
Qualana	高い分析精度を備え、位置ずれのない微小領域および広域マッピングを高精度に実現する先進的なX線分析装置。軽元素までも高感度で検出し、リガク独自のFPプログラムにより、柔軟な薄膜定量分析をサポート
SiC	シリコン(Si)と炭素(C)で構成される化合物半導体材料
SiGe	シリコン(Si)にゲルマニウム(Ge)で構成される合金半導体材料
TFXRD	半導体産業における薄膜特性の高精度な評価を目的としたX線回折(XRD)装置。特に、200mmおよび300mmの大口径ウェーハ上の薄膜の測定に対応しており、研究開発から製造プロセスのモニタリングまで幅広く利用されている
T-SAXS	Transmissive Small-Angle X-ray Scatteringの略称。透過型小角X線散乱法。物質にX線を透過させ、その散らばり方を分析することで、物質内部のナノメートルスケールの微細構造を非破壊で解析できる手法。半導体部品内部の微細な状態を詳しく確認する際に用いられる
WFE	Wafer Fab Equipment の略称。ウェーハを回路形成・検査するプロセスにおける製造装置を指す
X線CT	X線コンピュータ断層撮影（CT）は、対象物の密度分布を3Dで非破壊的にスキャンし、内部構造を明らかにするX線イメージング技術

用語	説明
XRD (回折)	• X線回折(XRD)。結晶試料にX線を照射するときに生じる回折パターンから試料の結晶構造情報を得る手法
XRF (蛍光)	• X-Ray Fluorescenceの略称。物質にX線を照射したときに発生する蛍光X線を利用して、定性分析や定量分析を行う元素分析手法
XRTmicron	• 高輝度X線光源と専用光学系を用いた高分解能・高速X線トポグラフィ装置。 Si、SiC、GaNなどの単結晶材料に対応。結晶欠陥を非破壊、全自動で検出できることから、半導体生産の歩留まり向上に寄与できる
XtaLAB Synergy ED	• リガクの単結晶X線構造解析の要素技術と日本電子の透過型電子顕微鏡の要素技術を組み合わせて作られた電子線回折装置。 従来よりも微細な粉末状の結晶でも測定が可能。これまで解析が困難であった物質でも構造情報を得ることができる
ZSX Primus III NEXT	• 定評のある上面照射型の走査型X線分析装置。生産管理で広く使われてきた汎用モデル「ZSX PrimusIII+」の後継機
ZSX Primus IV	• 4kWの強力なX線を用いて、物質に含まれる元素を詳しく調べる波長分散型のX線分析装置



免責事項

本プレゼンテーションに含まれる将来見通し、計画、戦略などは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、リスクや不確実性を含んでいます。実際の業績は、経済情勢や市場動向などの要因により、これらの見通しとは大きく異なる可能性があります。本資料は、当社株式の購入や売却を勧誘するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。本プレゼンテーションの内容は予告なく変更または削除される場合があります。また、本資料の利用により生じたいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。